

2Т392А-2

Бескорпусные кремниевые высокочастотные р-п-р транзисторы малой мощности

Типовое значение граничной частоты передачи тока $f_{ГР} = 450$ МГц

Максимальная рассеиваемая мощность коллектора $P_{Кмакс} = 120$ мВт

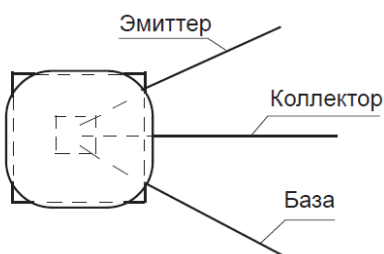
Максимальное постоянное напряжение коллектор-эмиттер $U_{Кэмакс} = 40$ В

Тип изделия	Тип корпуса	Диапазон рабочих температур
2Т392А-2	Без корпуса, сопроводительная тара ТС4, ТС16	-60°C до +85°C

Бескорпусные на диэлектрической подложке с гибкими выводами и защитным покрытием кремниевые планарно-эпитаксиальные р-п-р высокочастотные усилительные транзисторы 2Т392А-2 предназначены для использования в неремонтируемых гибридных схемах, микромодулях, узлах и блоках радиоэлектронной аппаратуры.

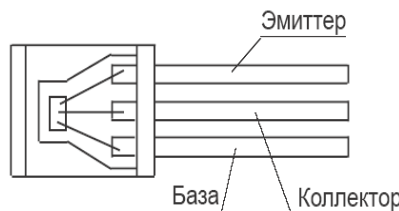
Знаком Н обозначаются изделия повышенной надежности.

Схема расположения выводов

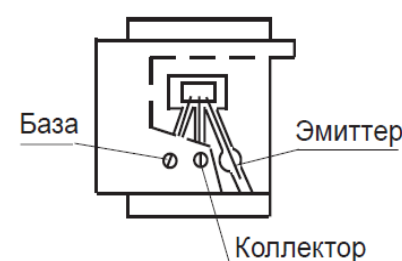


2Т392А-2

Сопроводительная тара



ТС4



ТС16

Основные электрические параметры при $T = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	2Т392А-2	
		не менее	не более
Обратный ток коллектора ($U_{КБ} = 40$ В), мкА	$I_{КБО}$		0,5
Обратный ток эмиттера ($U_{ЭБ} = 4$ В), мкА	$I_{ЭБО}$		0,5
Статический коэффициент передачи тока ($U_{КБ} = 5$ В, $I_{Э} = 2,5$ мА, $t_{и} \leq 2$ мс, $f \leq 50$ Гц)	$h_{21Э}$	40	180
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($U_{КБ} = 5$ В, $I_{Э} = 2,5$ мА, $f = 100$ МГц)	$ h_{21Э} $	3	
Граничная частота коэффициента передачи тока ($U_{КБ} = 5$ В, $I_{Э} = 2,5$ мА), МГц	$f_{ГР}$	300	
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте ($U_{КБ} = 5$ В, $I_{Э} = 2,5$ мА, $f = 30$ МГц), пс	τ_K		120
Емкость коллекторного перехода ($U_{КБ} = 5$ В, $f = 5$ МГц), пФ	C_K		2,5
Емкость эмиттерного перехода ($U_{ЭБ} = 1$ В, $f = 5$ МГц), пФ	$C_Э$		5
Коэффициент шума ($I_K = 100$ мА, $I_Б = 1$ мА), дБ	$K_{ш}$		4,3* - 4,8*

* - типовое



Предельные значения допустимых электрических режимов эксплуатации

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	2Т392А-2	Примечание
Максимально – допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В	$U_{кБ\max}$	40	
Максимально – допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{эБ} \leq 10 \text{ кОм}$, В	$U_{кЭ\max}$	40	
Максимально – допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В	$U_{эБ\max}$	4	
Максимально – допустимый постоянный ток коллектора, мА	$I_{к\max}$	10	
Импульсный ток коллектора при $t_i \leq 10 \text{ мкс}$, $Q \geq 2$, мА	$I_{ки\max}$	20	
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора в условной микросхеме, мВт при $T \leq +65^\circ\text{C}$ при $T = +85^\circ\text{C}$	$P_{к\max}$	120 88	
Тепловое сопротивление переход - кристаллодержатель, $^\circ\text{C}/\text{Вт}$	$R_{Тп-к}$	100	
Общее тепловое сопротивление, $^\circ\text{C}/\text{Вт}$	$R_{Тп-с}$	450	
Температура перехода, $^\circ\text{C}$	T_p	125	

Основные типовые зависимости параметров транзисторов

